

The Data Book Project

DatasheetArchive.com has launched an ambitious effort to digitize thousands of obsolete data books and technical manuals, making them searchable via the DatasheetArchive website.

Scroll down to see the scanned document.

2SC1447

シリコンNPN三重拡散形トランジスタ(PCT方式)
SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED TRANSISTOR (PCT PROCESS)

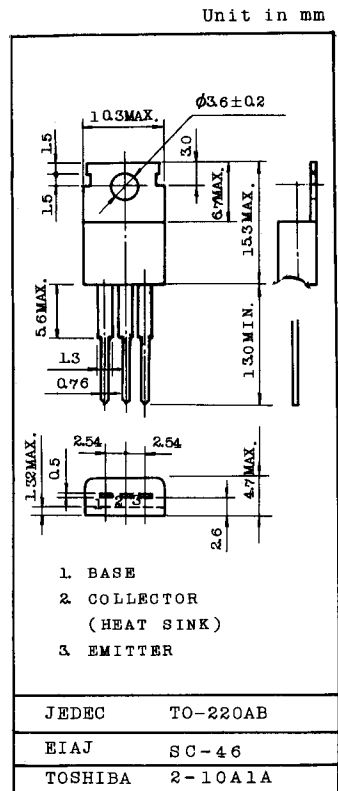
TENTATIVE

○ 電力増幅用

- Power Amplifier Applications
- ・ 高耐圧です: $V_{CE0} = 300V$
- ・ A級シングル段に用いて1Wとれます。
- ・ ラインオペレートテレビの音声出力段に適しています。
- ・ 1W at Class A Single Stage.
- ・ Recommended for Sound Output Stage in Line Operated TV.

最大定格 MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ C$)

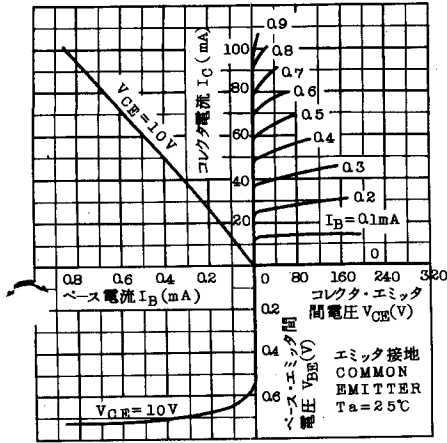
CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	V_{CE0}	300	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	300	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流	I_C	150	mA
エミッタ電流	I_E	-150	mA
コレクタ損失	P_C	$T_a = 25^\circ C$	1.5
		$T_c = 25^\circ C$	20
接合温度	T_j	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ 150	$^\circ C$

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25^\circ C$)アクセサリは AC75 を使用
MOUNTING KIT NO. AC-75

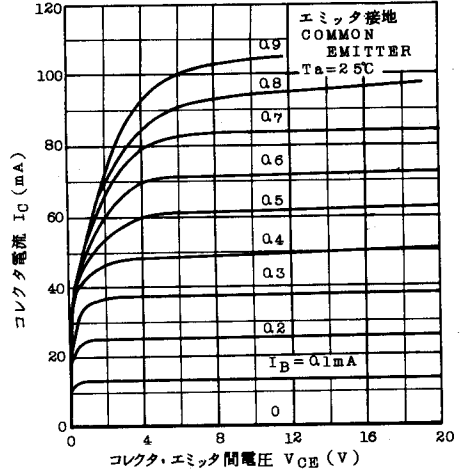
CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタしゅ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = 240V, I_E = 0$	-	-	1.0	
エミッタしゅ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = 5V, I_C = 0$	-	-	1.0	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = 5mA, I_B = 0$	300	-	-	V
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE} = 10V, I_C = 50mA$	40	-	170	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 100mA, I_B = 10mA$	-	-	3.0	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE} = 10V, I_C = 50mA$	0.6	-	0.9	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = 50V, I_E = -20mA$	40	80	-	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = 50V, I_E = 0$ $f = 1MHz$	-	7	12	pF

*PCT技術により製造されています。/ Produced by Perfect Crystal Device Technology.

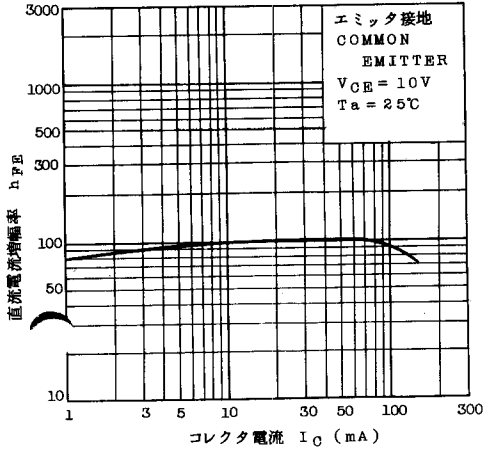
STATIC CHARACTERISTICS



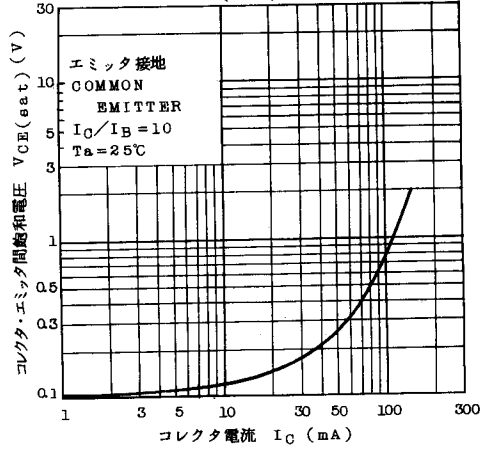
$I_C - V_{CE}$ (LOW VOLTAGE REGION)



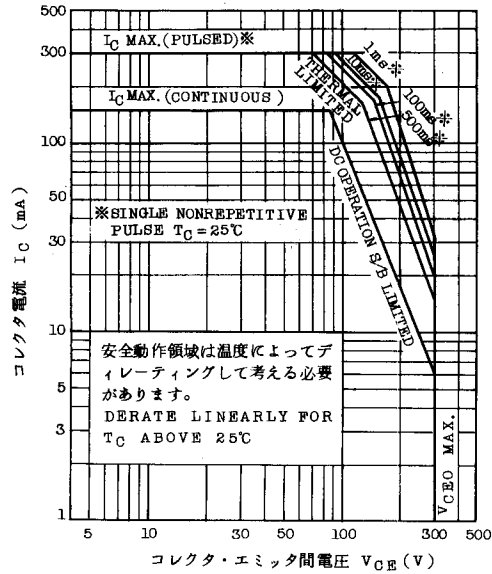
$h_{FE} - I_C$



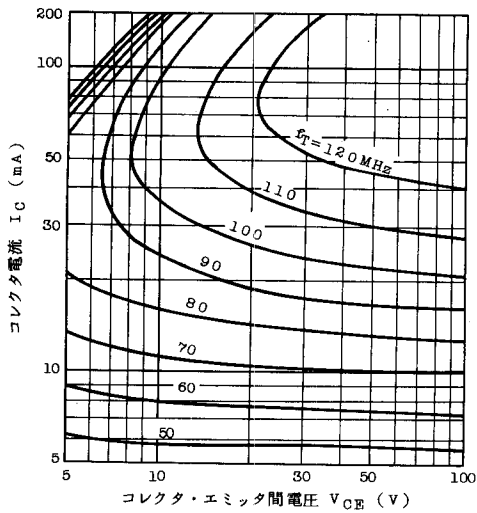
$V_{CE(sat)} - I_C$



安全動作領域 ASO



$f_T - I_C, V_{CE}$



$P_C - T_a$

